

Содержание

- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Исаева А.А., Смагин В.П.

Фотолюминесценция квантовых точек (Zn, Pb, Mn)S в полиакрилатной матрице 435

Ширяев А.А., Воротынцев В.М., Шоболов Е.Л.

Прогнозирование величины захваченного заряда в закороненном оксиде кремния структур кремний-на-изоляторе с применением эффекта Пула–Френкеля 441

Давыдов С.Ю.

Низкоразмерные структуры карбида кремния: аналитические оценки характеристик электронного спектра 446

Слипченко С.О., Подоскин А.А., Соболева О.С., Юферев В.С., Головин В.С., Гаврина П.С., Романович Д.Н., Мирошников И.В., Пихтин Н.А.

Исследования процессов транспорта носителей заряда в изотипных гетероструктурах типа n^+ -GaAs/ n^0 -GaAs/ n^+ -GaAs с тонким широкозонным барьером AlGaAs 452

Trir H., Radjhi L., Sengouga N., Tibermacine T., Arab L., Filali W., Abdelkader D., Attaf N.

Effect of Annealing on the Dark and Illuminated $I(V)$ Characterization of a ZnO:Ga|Cu₂O Hetero-junction Prepared by Ultrasonic Spray System 458

Botzakaki M.A., Skoulatakis G., Papageorgiou G.P., Krontiras C.A.

Interfacial Characterization and Transport Conduction Mechanisms in Al|HfO₂| p -Ge Structures: Energy Band Diagram 459

Sailai M., Aierken A., Qiqi L., Heini M., Zhao X., Mo J., Jie Guo, Hao R., Yu Z., Qi G.

Effects of 1-MeV Electron Irradiation on the Photoluminescence of GaInNAs|GaAs Single Quantum Well Structure 460

- Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Кононов А.А., Кастро Арата Р.А., Главная Д.Д., Стожаров В.М., Долгинцев Д.М., Сайто Ю., Фонс П., Анисимова Н.И., Колобов А.В.

Поляризационные процессы в тонких слоях аморфного MoS₂, полученных методом высокочастотного магнетронного распыления 461

- Физика полупроводниковых приборов

Маматкаримов О.О., Химматкулов О., Турсунов И.Г.

Влияние одноосной упругой деформации на вольт-амперную характеристику поверхностно-барьерных диодов Sb- p -Si(Mn)-Au 466

Тандоев А.Г., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н.

S-образные вольт-амперные характеристики мощных диодов Шоттки при больших плотностях тока 470

Соболева О.С., Головин В.С., Юферев В.С., Гаврина П.С., Пихтин Н.А., Слипченко С.О., Подоскин А.А.

Моделирование пространственной динамики включения лазера-тиристора ($\lambda = 905$ нм) на основе многопереходной гетероструктуры AlGaAs/InGaAs/GaAs 478

Подоскин А.А., Романович Д.Н., Шашкин И.С., Гаврина П.С., Соколова З.Н., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.

Модель управления конкуренцией замкнутых модовых структур в прямоугольных резонаторах большого размера на основе лазерных гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs 484

Kim J., Kim K.

A Novel 4H-SiC Super Junction UMOSFET with Heterojunction Diode for Enhanced Reverse Recovery Characteristics and Low Switching Loss 490

- Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Середин П.В., Голощяпов Д.Л., Золотухин Д.С., Леньшин А.С., Худяков Ю.Ю., Мизеров А.М., Тимошнев С.Н., Арсентьев И.Н., Бельтюков А.Н., Leiste Harald, Кукушкин С.А.

Влияние слоя нанопористого кремния на практическую реализацию и особенности эпитаксиального роста слоев GaN на темплейтах SiC/ por -Si/ c -Si 491

Болотов В.В., Ивлев К.Е., Князев Е.В., Пономарева И.В., Росликов В.Е.

Формирование многослойных структур с интегрированными мембранами на основе пористого кремния 504